

ISSN 1999-8074

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА
НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР МОНМС та НАН УКРАЇНИ
КОНЦЕРН “ЦЕНТР НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ”
ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
“ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Физическая инженерия поверхности

ВИДАЄТЬСЯ 4 РАЗИ НА РІК

**Фізична
інженерія
поверхні**

ЗАСНОВАНИЙ У 2002 РОЦІ

**Physical
surface
engineering**

Том 11, № 2, квітень – червень 2013

ХАРКІВ 2013

Редакційна колегія

М.О. Азаренков (головний редактор), В.І. Фареник (перший заступник головного редактора), В.М. Береснєв (заступник головного редактора), П.В. Турбін (заступник головного редактора), Т.М. Беляєва (відповідальний секретар), Л.О. Агеев, О.С. Бакай, Б.В. Гриньов, Ю.С. Гордіенко, М.І. Дзюбенко, А.М. Довбня, С.П. Дюбко, В.О. Євстратов, В.Д. Егоренков, О.М. Єрмоляєв, Г.В. Задорожний, З.З. Зиман, В.Ф. Клепіков, А.М. Кондратенко, Г.І. Костюк, В.М. Куклін, В.І. Лахно, В.К. Мілославський, І.М. Неклюдов, А.Т. Пугачов, В.В. Сагалович, В.А. Свіч, А.Ф. Сиренко, В.М. Хороших, О.О. Шматко

Міжнародна редакційна рада

Р. Антон (Гамбург, Німеччина), В.Г. Бар'яхтар (Київ, Україна), В. Бук (Ессен, Німеччина), Ж.-П. Бут (Париж, Франція), К.А. Валиєв (Москва, Росія), І. Вайткус (Вільнюс, Литва), Я. Валькович (Радом, Польща), В.Г. Вербицький (Київ, Україна), В.С. Войценя (Харків, Україна), Ю.І. Горобець (Київ, Україна), В.І. Гранико (Мінськ, Беларусь), А.П. Достанко (Мінськ, Беларусь), В. Ензінтер (Марбург, Німеччина), П. Жуковський (Люблін, Польща), О.В. Зиков (Харків, Україна), К.К. Кадиржанов (Алма-Ати, Казахстан), В.Г. Каплун (Хмельницький, Україна), В. Кемптер (Клаусталь-Целлерфельд, Німеччина), Г.С. Кириченко (Київ, Україна), Ю.М. Клещов (Снєжинськ, Росія), Ю.Р. Колобов (Белгород, Росія), Ф.Ф. Комаров (Мінськ, Беларусь), М.М. Кондрашов (Київ, Україна), В.М. Косевич (Харків, Україна), С. Курода (Сенген, Японія), В.А. Лабунов (Мінськ, Беларусь), С.Ю. Ларкін (Київ, Україна), Є.О. Левашов (Москва, Росія), Ю.П. Маішев (Москва, Росія), А. Мазуркевич (Радом, Польща), П. Місаэлідес (Тессалоніки, Греція), А.Г. Наумовець (Київ, Україна), М.Г. Находкін (Київ, Україна), В.І. Осинський (Київ, Україна), О.С. Павличенко (Харків, Україна), О.Д. Погребняк (Суми, Україна), Л. Пранявичус (Каунас, Литва), Ж.П. Рів'єр (Париж, Франція), В.Є. Стрельницький (Харків, Україна), А.М. Філачев (Москва, Росія), Д.М. Фрейк (Івано-Франківськ, Україна), Ж.Г. Хан (Сувон, Корея)

Адреса редакції: НФТЦ МОН та НАН України, майдан Свободи, 6, м. Харків, 61022, а/с 4499, Україна

Тел. 38 057 7054667, e-mail: journal_pse@ukr.net, <http://www.pse.scpt.org.ua>

Редакційна колегія

Н.А. Азаренков (главный редактор), В.И. Фареник (первый заместитель главного редактора), В.М. Береснев (заместитель главного редактора), П.В. Турбин (заместитель главного редактора), Т.Н. Беляева (ответственный секретарь), Л.А. Агеев, А.С. Бакай, Ю.Е. Гордиенко, Б.В. Гринев, М.И. Дзюбенко, А.Н. Довбня, С.Ф. Дюбко, В.А. Евстратов, В.Д. Егоренков, О.М. Ермоляев, Г.В. Задорожный, З.З. Зиман, В.Ф. Клепиков, А.Н. Кондратенко, Г.И. Костюк, В.М. Куклин, В.И. Лахно, В.К. Мілославский, И.М. Неклюдов, А.Т. Пугачев, В.В. Сагалович, В.А. Свіч, А.Ф. Сиренко, В.М. Хороших, А.А. Шматко

Міжнародний редакційний совет

Р. Антон (Гамбург, Германия), В.Г. Барьяхтар (Киев, Украина), В. Бук (Эссен, Германия), Ж.-П. Бут (Париж, Франция), К.А. Валиев (Москва, Россия), И. Вайткус (Вильнюс, Литва), Я. Валькович (Радом, Польша), В.Г. Вербицкий (Киев, Украина), В.С. Войценя (Харьков, Украина), Ю.И. Горобец (Киев, Украина), В.І. Гранико (Минск, Беларусь), А.П. Достанко (Минск, Беларусь), П. Жуковский (Люблин, Польша), А.В. Зыков (Харьков, Украина), К.К. Кадиржанов (Алма-Аты, Казахстан), В.Г. Каплун (Хмельницкий, Украина), В. Кемптер (Клаусталь-Целлерфельд, Германия), Г.С. Кириченко (Киев, Украина), Ю.Н. Клещев (Снежинск, Россия), Ю.Р. Колобов (Белгород, Россия), Ф.Ф. Комаров (Минск, Беларусь), Н.Н. Кондрашов (Киев, Украина), В.М. Косевич (Харьков, Украина), С. Курода (Сенген, Япония), В.А. Лабунов (Минск, Беларусь), С.Ю. Ларкін (Киев, Украина), Е.А. Левашов (Москва, Россия), Ю.П. Маішев (Москва, Россия), А. Мазуркевич (Радом, Польша), П. Місаэлідес (Тессалоніки, Греція), А.Г. Наумовець (Київ, Україна), Н.Г. Находкін (Київ, Україна), В.І. Осинський (Київ, Україна), О.С. Павличенко (Харьков, Украина), А.Д. Погребняк (Суми, Украина), Л. Пранявичус (Каунас, Литва), Ж.П. Рів'єр (Париж, Франція), В.Є. Стрельницький (Харьков, Україна), А.М. Філачев (Москва, Россия), Д.М. Фрейк (Івано-Франківськ, Україна), Ж.Г. Хан (Сувон, Корея), В. Ензінтер (Марбург, Германия)

Адрес редакції: НФТЦ МОН та НАН України, площа Свободи, 6, г. Харків, 61022, п/я 4499, Україна

Тел. 38 057 7054667, e-mail: journal_pse@ukr.net, <http://www.pse.scpt.org.ua>

Editorial Board

М.О. Azarenkov (Editor-in-Chief), V.I. Farenik (Vice Editor-in-Chief), V.M. Beresnyev (Associate Editor-in-Chief), P.V. Turbin (Associate Editor-in-Chief), T.M. Byelyayeva (Executive secretary), L.O. Ageev, O.S. Bakai, M.I. Dzyubenko, A.M. Dovbnya, S.P. Dyubko, O.M. Ermolaev, V.O. Evstratov, (Associate Editor-in-Chief), Yu.Ye. Gordienko, B.V. Griniov, V.M. Khoroshikh, V.F. Klepikov, A.M. Kondratenko, G.I. Kostyuk, V.M. Kuklin, V.I. Lakhno, V.K. Miloslavsky, I.M. Neklyudov, A.T. Pugachev, V.V. Sagalovich, O.O. Shmatko, A.P. Sirenko, V.A. Svich, V.D. Yegorenkov, G.V. Zadorozhny, Z.Z. Zyman

International Advisory Editorial Board

R. Anton (Hamburg, Germany), V.G. Baryakhtar (Kyiv, Ukraine), J.-P. Booth (Paris, France), V. Buck (Essen, Germany), A.P. Dostanko (Minsk, Byelorussia), W. Ensinger (Marburg, Germany), A.M. Filachev (Moscow, Russia), D.M. Freik (Ivano-Frankivsk, Ukraine), Yu.I. Gorobets (Kyiv, Ukraine), V.I. Granko (Minsk, Byelorussia), J.G. Han (Suwon, Korea), K.K. Kadyrzhanov (Alma-Aty, Kazakhstan), V.G. Kaplun (Khmelnytskyj, Ukraine), V. Kempter (Clausthal-Zellerfeld, Germany), G.S. Kirichenko (Kyiv, Ukraine), Yu.M. Kleshev (Snezhinsk, Russia), Yu.R. Kolobov (Byelgorod, Russia), F.F. Komarov (Minsk, Byelorussia), M.M. Kondrashov (Kyiv, Ukraine), V.M. Kosevich (Kharkiv, Ukraine) S. Kuroda (Sengen, Japan), V.A. Labunov (Minsk, Byelorussia), S.Yu. Larkin (Kyiv, Ukraine), E.A. Levashov (Moscow, Russia), Yu.P. Maishev (Moscow, Russia), A. Mazurkiewicz (Radom, Poland), P. Misaelides (Thessaloniki, Greece), M.G. Nakodkin (Kyiv, Ukraine), A.G. Naumovets (Kyiv, Ukraine), V.I. Osinsky (Kyiv, Ukraine), O.S. Pavlichenko (Kharkiv, Ukraine), O.D. Pogrebnyak (Sumy, Ukraine), L. Pranavicius (Kaunas, Lithuania), J.-P. Rivier (Paris, France), V.Ye. Strelntsikij (Kharkiv, Ukraine), J. Vaitkus (Vilnius, Lithuania), K.A. Valiev (Moscow, Russia), V.G. Verbitskij (Kyiv, Ukraine), V.S. Voitsenya (Kharkiv, Ukraine), J. Walkowicz (Radom, Poland), P. Zhukowsky (Lyublin, Poland), O.V. Zykov (Kharkiv, Ukraine)

Address: SCPT MES & NAS Ukraine, 6 Svobody Sq., Kharkiv, 61022, box 4499, Ukraine

Tel. 38 057 7054667, e-mail: journal_pse@ukr.net, <http://www.pse.scpt.org.ua>

Затверджено до друку рішенням

Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, (протокол № 6 від 1 червня 2013 р.),

Вченої ради Наукового фізико-технологічного центру, (протокол № 6 від 28 травня 2013 р.)

Статті пройшли внутрішнє та зовнішнє рецензування.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9214 від 29.09.04.

© Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, оформлення, 2013

© Науковий фізико-технологічний центр, оригінал-макет, 2013

© Концерн "ЦНТ" Харківський фізико-технічний інститут, оформлення, 2013

© "Центр науково-технічних досліджень", оформлення, 2013

<i>Долгов А.С., Валуйская А.В.</i> Миграция взаимодействующих атомов в поверхностном монослое	144
<i>Зубко Е.І.</i> Функціоналізація і наноструктурування поверхневих шарів поруватого кремнію	154
<i>Каверин М.В., Krause-Rehberg R., Береснев В.М., Постольный Б.А., Колесников Д.А., Якущенко И.В., Билокур М.А., Жоллыбеков Б.Р.</i> Влияние дефектов и примесных атомов на физико-механические свойства наноструктурных покрытий в области границ их раздела	160
<i>Кудринський З.Р.</i> Топология поверхні тонких оксидних плівок CdO, сформованих на ван-дер-ваальсовых поверхнях шаруватих кристалів InSe TA GaSe	185
<i>Дадамирзаев М.Г.</i> Разогрев электронов и дырок в несимметричном <i>p-n</i> -переходе, находящемся в СВЧ поле	191
<i>Гулямов Г., Шарибаев Н.Ю., Эркабоев У.И.</i> Влияние эффективной массы плотности состояний на температурную зависимость ширины запрещенной зоны в твердых растворах <i>p</i> -Bi _{2-x} Sb _x Te _{3-y} Se _y	195
<i>Ёдгорова Д.М., Каримов А.В., Каримов А.А.</i> Исследование процессов модуляции базовой области кремниевой <i>p⁺-n⁺</i> -структуре	199
<i>Береснев В.М., Турбин П.В., Грудницкий В.В., Торянник И.С., Дмитренко А.Е., Кропотов А.Ю., Гриценко В.И., Маликов Л.В., Гранкин С.С.</i> Применение многокомпонентных катодов, полученных электронно-лучевым плавлением, для формирования сверхтвердых нанокомпозитных покрытий	204
<i>Олимов Л.О., Майдинова М., Омонбоев Ф.Л.</i> Электрические свойства межзеренных границ в объеме поликристаллического кремния	212
<i>Мирсагатов Ш.А., Ачилов А.С., Заверюхин Б.Н.</i> Тонкопленочные детекторные CdTe-структуры с барьером Шоттки	216
<i>Санаев И.Б.</i> Исследование электрических и фотоэлектрических свойств In-CdS _x Te _{1-x} -Si-In структуры	223
<i>Шарибаев Н.Ю.</i> Исследования температурной зависимости ширины запрещенной зоны Si и Ge с помощью модели	228
<i>Пилипенко Н.Н., Дробышевская А.А., Ажажса Р.В., Стадник Ю.С., Танцюра И.Г.</i> Термооксидные покрытия на циркониевых материалах	231
<i>Яремій І.П., Томін У.О., Уманців М.М., Кравець В.І.</i> Вплив імплантациї іонами гелію на форму елементарної комірки у приповерхневих шарах монокристалів	237
<i>Гулямов Г., Гулямов А.Г., Мажидова Г.Н.</i> Тензорезистивный эффект в системе потенциальных барьеров в полупроводниковых пленках ..	243
<i>Правила оформлення рукописей</i>	246
<i>Правила оформлення рукописів</i>	247
<i>Information for authors</i>	248